

### W-LAN 用 2.4 GHz 帯 シングル・バンド・パワー・アンプ

μPG2315T5T は W-LAN 用 2.4 GHz 帯シングル・バンド・パワー・アンプとして開発した GaAs HBT MMIC です。本製品は InGaP (インジウム・ガリウム・リン) HBT (ヘテロ接合型トランジスタ) を採用することで、高効率、高利得、高出力特性を有しています。パッケージは高密度・面実装が可能な 16 ピン・プラスチック QFN (Quad Flat Non-leaded) を採用しています。

#### 特 徴

- 動作周波数 :  $f_{opt} = 2\,400 \sim 2\,500$  MHz (2 450 MHz TYP.)
  - 電源電圧 :  $V_{CC1, 2} = 3.0 \sim 3.6$  V (3.3 V TYP.)
  - 制御電圧 :  $V_{enable} = 0 \sim 2.95$  V (2.85 V TYP.)
  - 回路電流 :  $I_{CC} = 130$  mA TYP. @  $V_{CC1, 2} = 3.3$  V,  $V_{enable} = 2.85$  V,  $P_{out} = +18$  dBm (OFDM 変調時)
  - 電力利得 :  $G_P = 26$  dB TYP. @  $V_{CC1, 2} = 3.3$  V,  $V_{enable} = 2.85$  V,  $P_{out} = +18$  dBm (OFDM 変調時)
  - 利得偏差 :  $\Delta G_P = 1.0$  dB TYP. @  $f = 2.4 \sim 2.5$  GHz,  $V_{CC1, 2} = 3.3$  V,  $V_{enable} = 2.85$  V,  $P_{out} = +18$  dBm (OFDM 変調時)
  - 変調精度 :  $EVM = 3\%$  TYP. @  $V_{CC1, 2} = 3.3$  V,  $V_{enable} = 2.85$  V,  $P_{out} = +18$  dBm (OFDM 変調時)
  - 高調波 :  $2f_0, 3f_0, 4f_0 = 30$  dBc TYP. @  $V_{CC1, 2} = 3.3$  V,  $V_{enable} = 2.85$  V,  $P_{out} = +18$  dBm (OFDM 変調時)
- 高密度・面実装が可能 : 16 ピン・プラスチック QFN パッケージ (3.0 × 3.0 × 0.75 mm)

#### 用 途

W-LAN (802.11 b/g) および DECT 用パワー・アンプ

#### オーダ情報

品名	オーダ名称	パッケージ	捺 印	包装形態
μPG2315T5T-E2	μPG2315T5T-E2-A	16 ピン・プラスチック QFN (鉛フリー)	2315	・ 8 mm 幅エンボス式テーピング ・ 1, 12 ピン側が送り丸穴 ・ 3 k 個 / リール

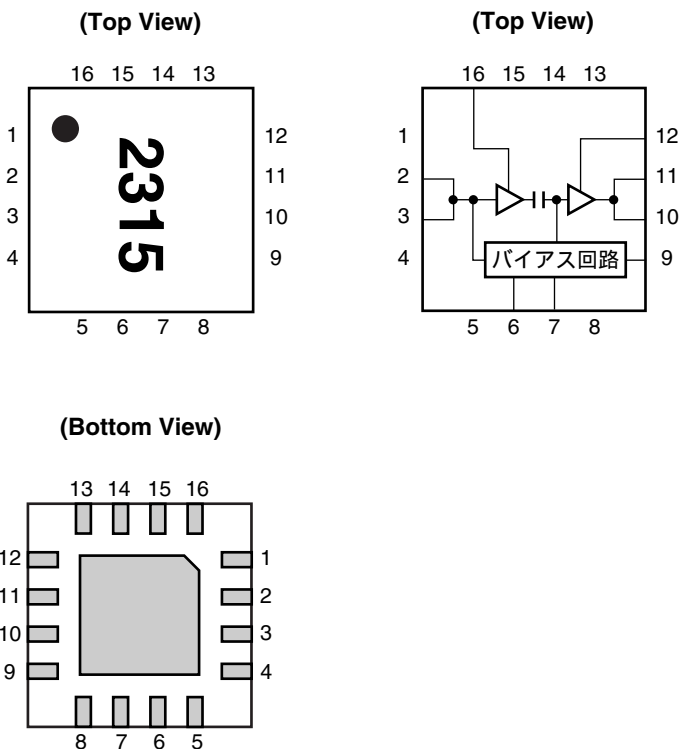
備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください。

サンプル名称 : μPG2315T5T

**注意** 本製品は静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

端子接続図および内部ブロック図



端子番号	端子名称
1	N.C.
2	INPUT
3	INPUT
4	N.C.
5	N.C.
6	V <sub>enable1</sub>
7	V <sub>enable2</sub>
8	N.C.
9	V <sub>det</sub>
10	OUTPUT
11	OUTPUT
12	V <sub>cc2</sub>
13	N.C.
14	N.C.
15	N.C.
16	V <sub>cc1</sub>

絶対最大定格（特に指定のないかぎり T<sub>A</sub> = +25°C）

項目	略号	定格	単位
電源電圧	V <sub>cc1, 2</sub>	5.0	V
制御電圧	V <sub>enable</sub>	4.0	V
入力電力	P <sub>in</sub>	+ 10	dBm
パッケージ許容損失	P <sub>D</sub>	500 <sup>注</sup>	mW
動作周囲温度	T <sub>A</sub>	- 45 ~ + 85	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	- 55 ~ + 150	°C

注 50 × 50 × 1.6 mm 両面銅箔ガラス・エポキシ基板実装時，T<sub>A</sub> = + 85°C

推奨動作範囲（特に指定のないかぎり T<sub>A</sub> = +25°C）

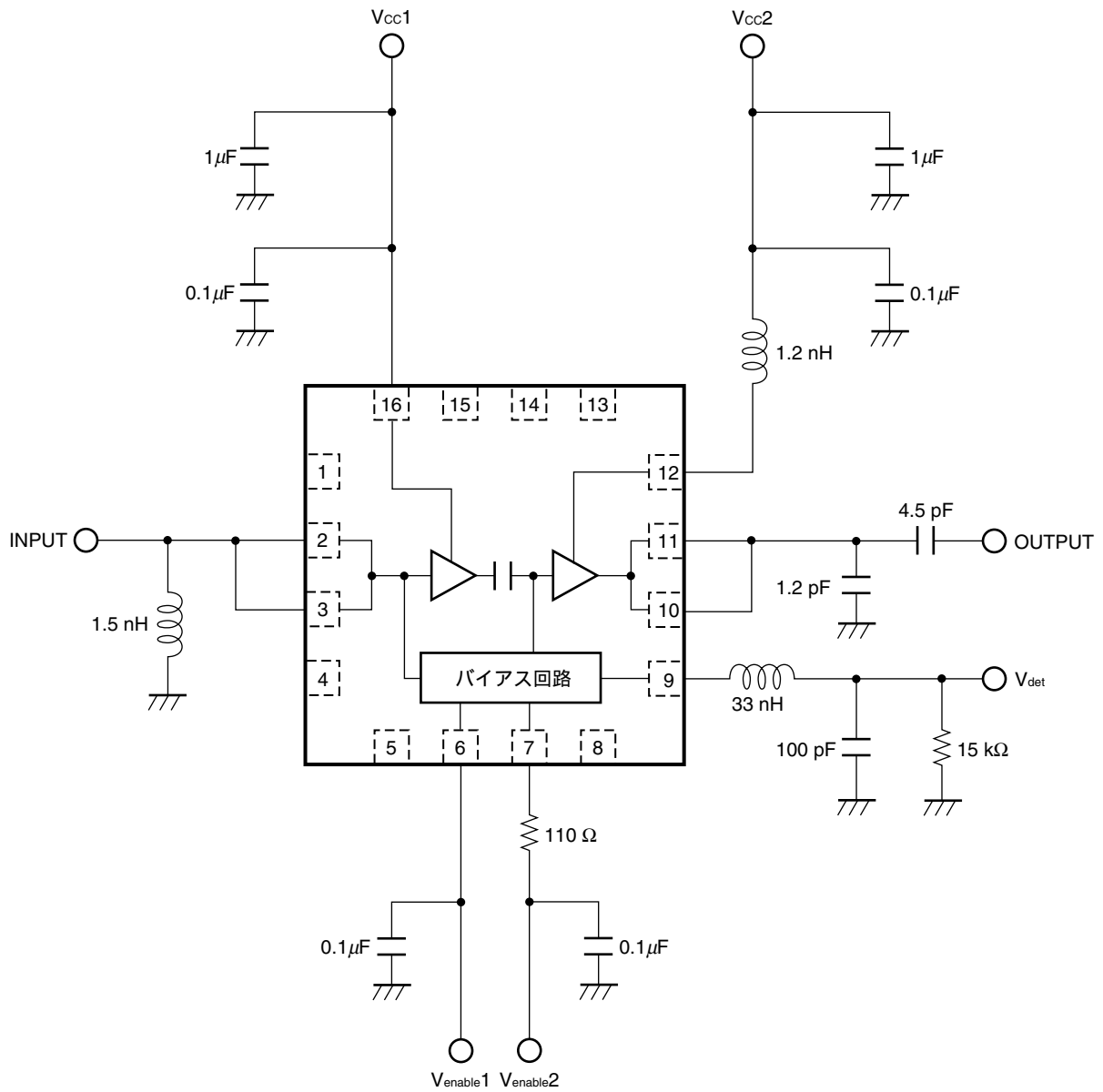
項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
動作周波数	f <sub>opt</sub>	2 400	2 450	2 500	MHz
電源電圧	V <sub>cc1, 2</sub>	3.0	3.3	3.6	V
制御電圧	V <sub>enable</sub>	0	2.85	2.95	V

## 電気的特性

(特に指定のないかぎり  $T_A = +25^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC1, 2} = 3.3\text{ V}$ ,  $V_{enable} = 2.85\text{ V}$ ,  $f = 2\,400\text{ to }2\,500\text{ MHz}$ ,  
入出力側外部整合時)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
回路電流	$I_{CC}$	$P_{out} = +18\text{ dBm}$ (OFDM 変調時)	-	130	150	mA
電力利得	$G_P$	$P_{out} = +18\text{ dBm}$ (OFDM 変調時)	23	26	-	dB
利得平坦度	$\Delta G_P$	$P_{out} = +18\text{ dBm}$ (OFDM 変調時)	-	1.0	1.5	dB
変調精度	EVM	$P_{out} = +18\text{ dBm}$ (OFDM 変調時)	-	3.0	-	%
入力側リターン・ロス	$RL_{in}$	$P_{in} = -30\text{ dBm}$	-	15	-	dB
出力側リターン・ロス	$RL_{out}$	$P_{in} = -30\text{ dBm}$	-	10	-	dB
2次高調波	$2f_0$	$P_{out} = +18\text{ dBm}$ (OFDM 変調時)	-	30	-	dBc
3次高調波	$3f_0$	$P_{out} = +18\text{ dBm}$ (OFDM 変調時)	-	30	-	dBc
4次高調波	$4f_0$	$P_{out} = +18\text{ dBm}$ (OFDM 変調時)	-	30	-	dBc
パワー・ディテクタ電圧	$V_{det}$		0.5	-	2.0	V

評価回路図

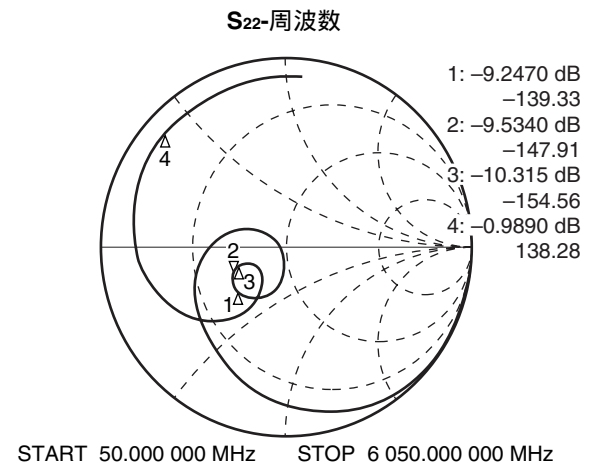
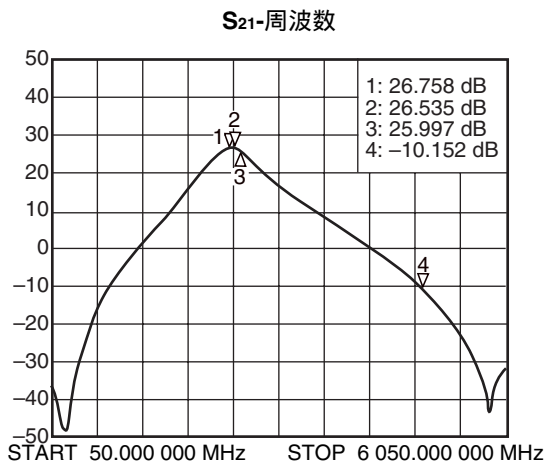
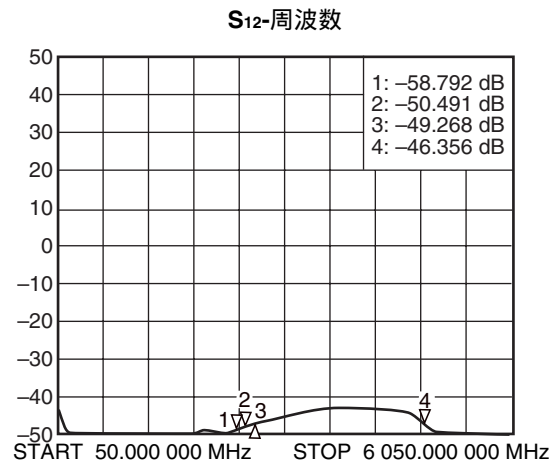
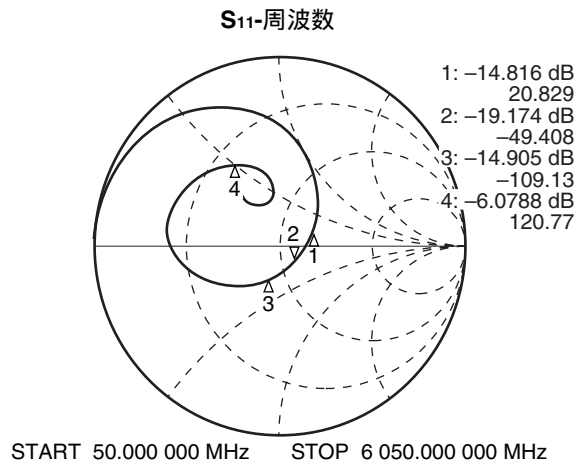


本資料に掲載の応用回路および回路定数は、例示的に示したものであり、量産設計を対象とするものではありません。

特性曲線

S パラメータ (標準データ) - 本データは外付けマッチング回路を含むデータです。 -

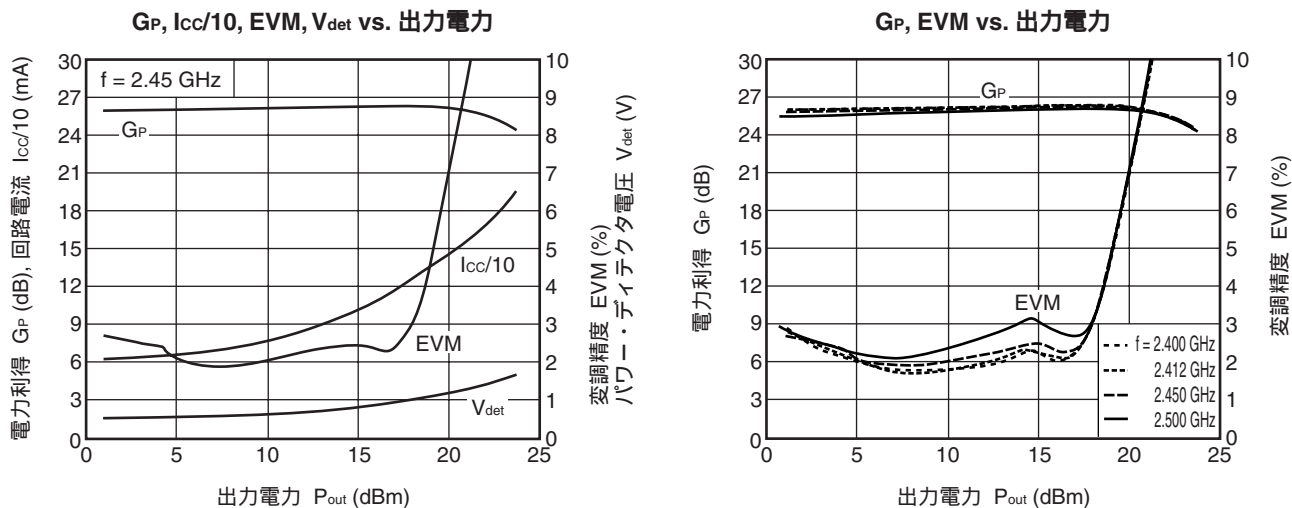
条件 : 特に指定のないかぎり  $V_{cc1} = V_{cc2} = 3.3\text{ V}$ ,  $V_{enable1} = V_{enable2} = 2.85\text{ V}$ ,  $I_q = 58\text{ mA}$ , 参考値



備考 1. グラフ中の値は参考値を示します。

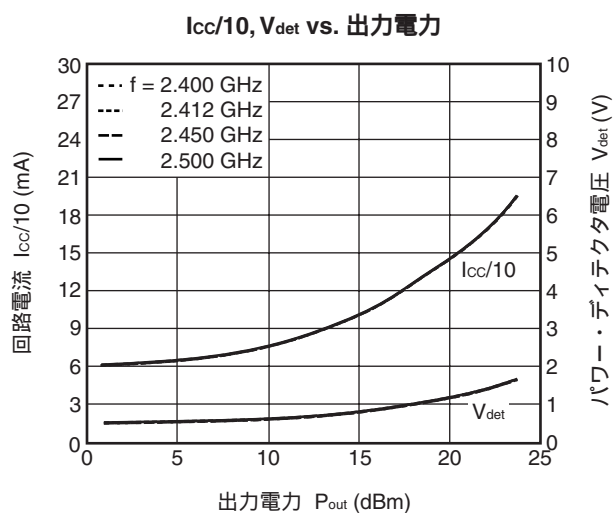
- 2. Marker1 : 2.40 GHz
- Marker2 : 2.45 GHz
- Marker3 : 2.50 GHz
- Marker4 : 4.90 GHz

標準パワー特性データ (特に指定のないかぎり  $V_{cc1} = V_{cc2} = 3.3\text{ V}$ ,  $V_{enable1} = V_{enable2} = 2.85\text{ V}$ , 参考値)



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

標準 V<sub>det</sub> 特性データ (特に指定のないかぎり  $V_{cc1} = V_{cc2} = 3.3\text{ V}$ ,  $V_{enable1} = V_{enable2} = 2.85\text{ V}$ , 参考値)

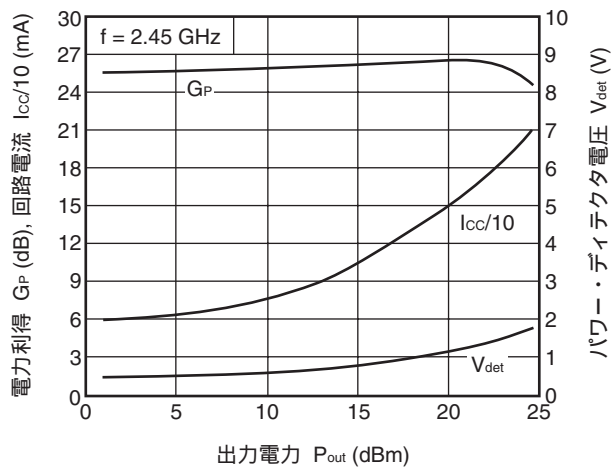


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

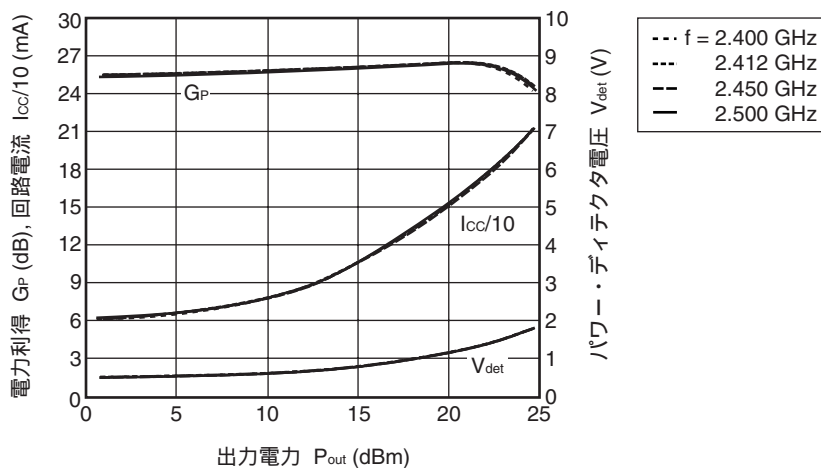
標準 802.11b パワー特性データ

(特に指定のないかぎり  $V_{cc1} = V_{cc2} = 3.3\text{ V}$ ,  $V_{enable1} = V_{enable2} = 2.85\text{ V}$ , 参考値)

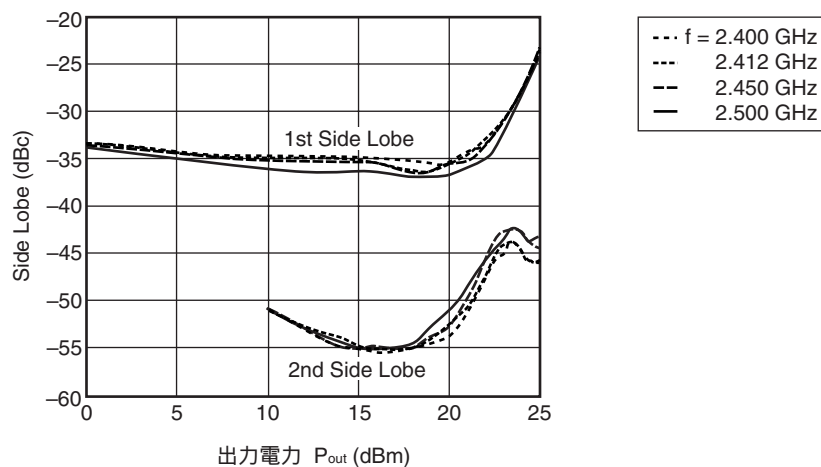
$G_P$ ,  $I_{cc}/10$ ,  $V_{det}$  vs. 出力電力



$G_P$ ,  $I_{cc}/10$ ,  $V_{det}$  vs. 出力電力

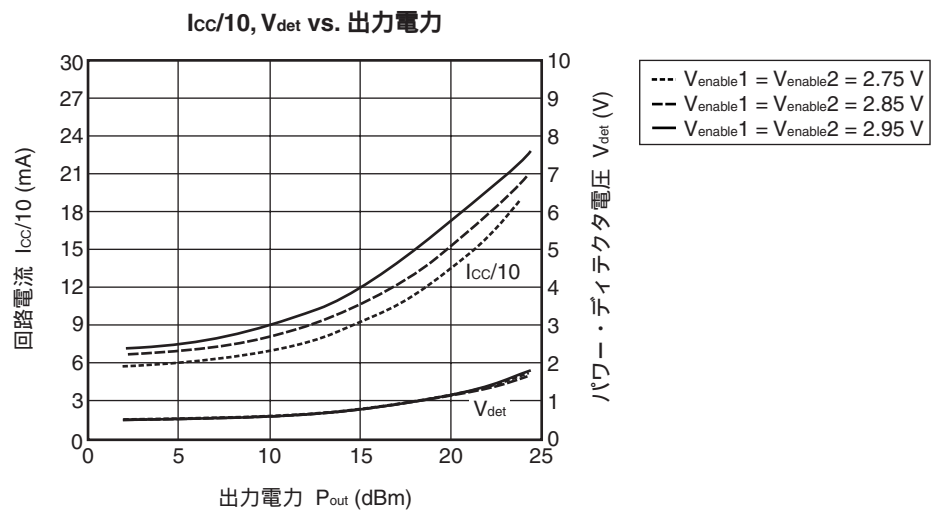
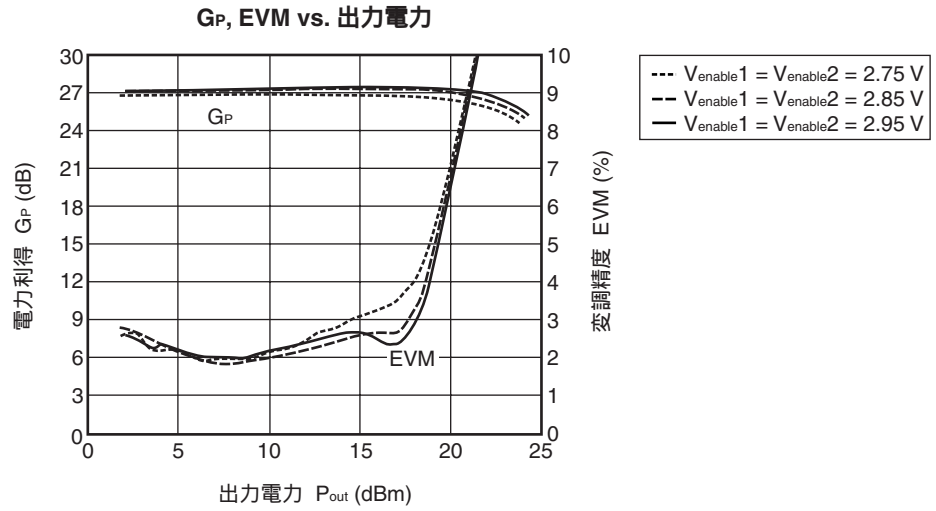


Side Lobe vs. 出力電力



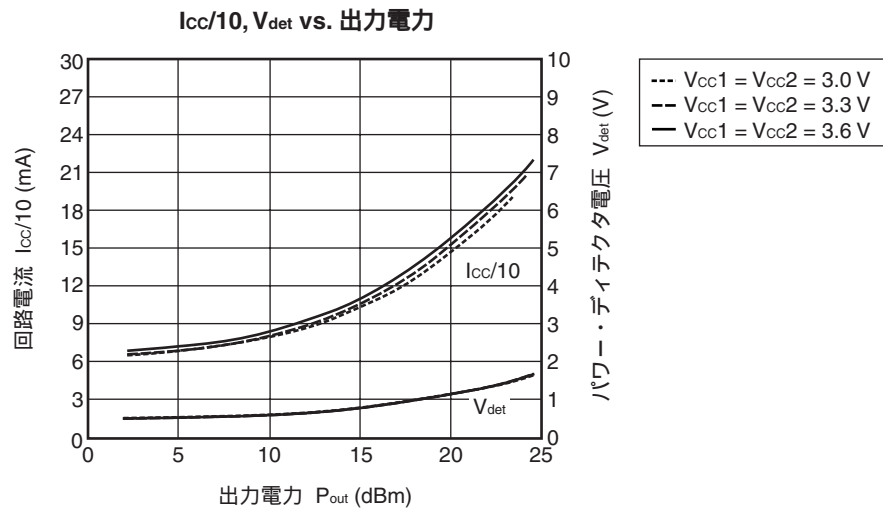
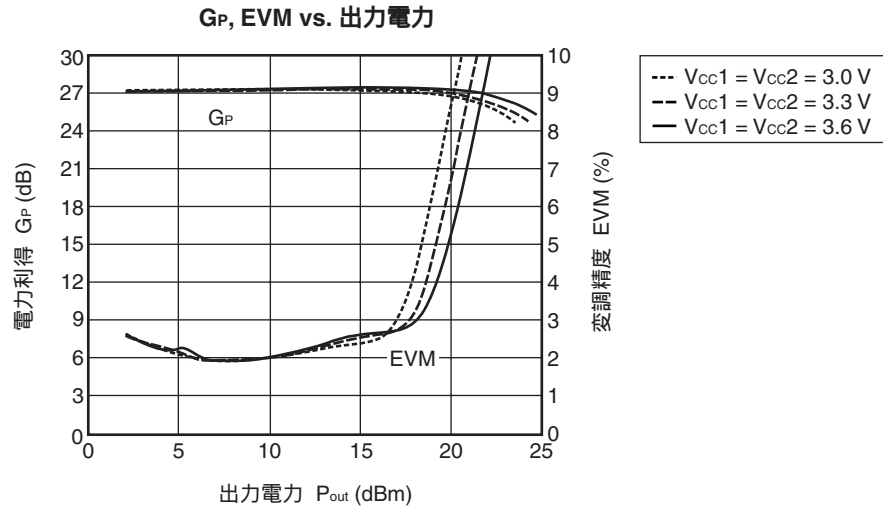
備考 グラフ中の値は参考値を示します。

標準  $V_{enable}$  電圧パワー依存性データ (特に指定のないかぎり  $f = 2.45 \text{ GHz}$ ,  $V_{cc1} = V_{cc2} = 3.3 \text{ V}$ , 参考値)



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

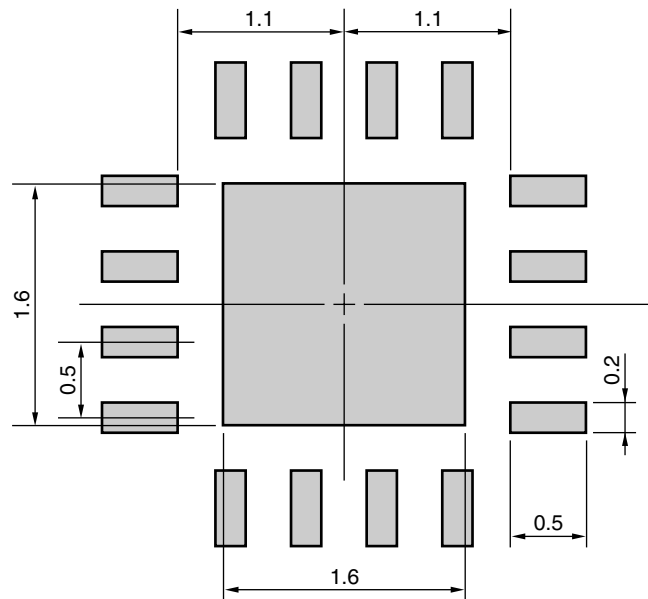
標準電源電圧パワー依存性データ(特に指定のないかぎり  $f = 2.45 \text{ GHz}$ ,  $V_{\text{enable1}} = V_{\text{enable2}} = 2.85 \text{ V}$ , 参考値)



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

ランド・パターン図

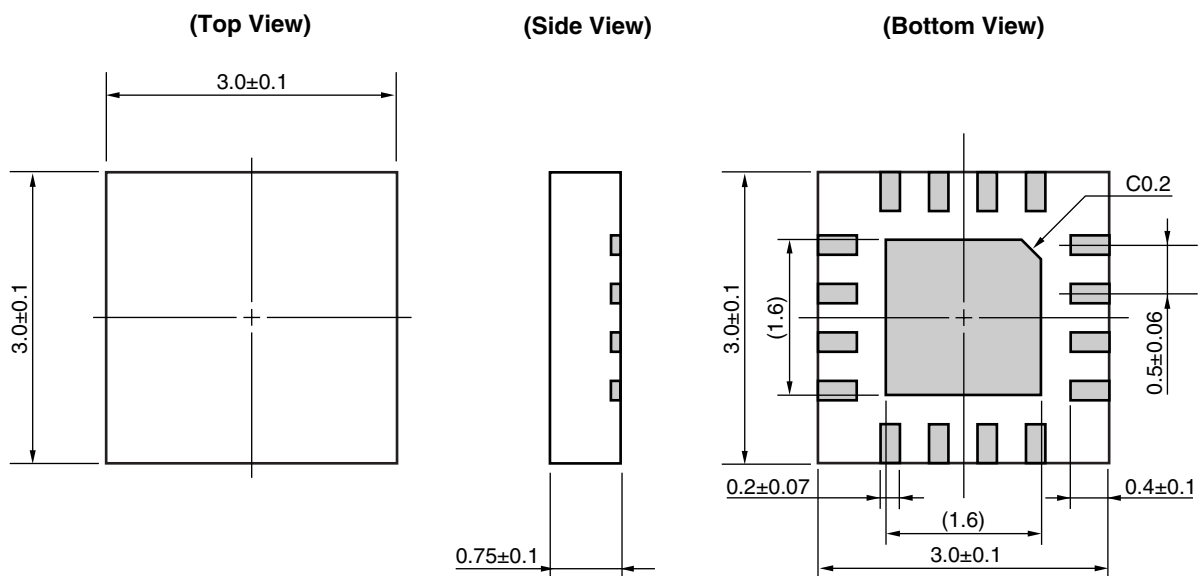
16ピン・プラスチックQFN（単位：mm）



備考 本ランド・パターン図面は一例を示したものです。

外形図

16ピン・プラスチックQFN（単位：mm）



備考 ( )内の寸法は参考値

**半田付け推奨条件**

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最高温度（パッケージ表面温度） : 260°C 以下</li> <li>・ 最高温度の時間 : 10 秒以内</li> <li>・ 温度 220°C 以上の時間 : 60 秒以内</li> <li>・ プリヒート温度 120 ~ 180°C の時間 : 120±30 秒</li> <li>・ 最多リフロ回数 : 3 回</li> <li>・ ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下</li> </ul>	IR260
ウェーブ・ソルダーリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最高温度（溶融半田温度） : 260°C 以下</li> <li>・ フロー時間 : 10 秒以内</li> <li>・ プリヒート温度（パッケージ表面温度） : 120°C 以下</li> <li>・ フロー回数 : 1 回</li> <li>・ ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下</li> </ul>	WS260
端子部分加熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 最高温度（端子部温度） : 350°C 以下</li> <li>・ 時間（デバイスの一辺あたり） : 3 秒以内</li> <li>・ ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%（Wt.）以下</li> </ul>	HS350

**注意** 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱は除く）。

- 本資料に記載されている内容は2006年9月現在のものです。今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めておりますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命、身体および財産に対する損害の危険を最小限度にするために、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

(注)

- (1) 本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
- (2) 本事項において使用されている「当社製品」とは、(1)において定義された当社の開発、製造製品をいう。

M8E 02.11

<b>注意</b> GaAs 製品	<p>この製品には、ガリウムヒ素（GaAs）を使用しています。 GaAs の粉末や蒸気は有害ですから、次の点にご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・廃棄する際には、次のような廃棄処理をすることを推奨します。<ol style="list-style-type: none"><li>1. 「ヒ素含有物等の産業廃棄物の収集、運搬、処理の資格」を持つ処理業者に委託する。</li><li>2. 一般産業廃棄物および家庭用廃棄物とは区別し、「特別管理産業廃棄物」として、最終処分まで管理する。</li></ol></li><li>・焼却、破壊、切断、粉碎や化学的な分解を行わないでください。</li><li>・対象デバイスをなめたり、口に入れたりしないでください。</li></ul>
-------------------	--

NECエレクトロニクス株式会社 化合物デバイス事業部  
[http://www.ncsd.necel.com/index\\_j.html](http://www.ncsd.necel.com/index_j.html)

営業に関する問い合わせ先（購入、サンプル、品質、RoHSなど）  
E-mail : [csd\\_salesinfo@ml.necel.com](mailto:csd_salesinfo@ml.necel.com) TEL : 044-435-1838

技術に関する問い合わせ先（規格、特性、使い方など）  
E-mail : [csd\\_techinfo@ml.necel.com](mailto:csd_techinfo@ml.necel.com) TEL : 044-435-1577  
問い合わせサイト : [https://e-sv.ncsd.necel.com/ncsd/contact/techinfo\\_form\\_j.html](https://e-sv.ncsd.necel.com/ncsd/contact/techinfo_form_j.html)